

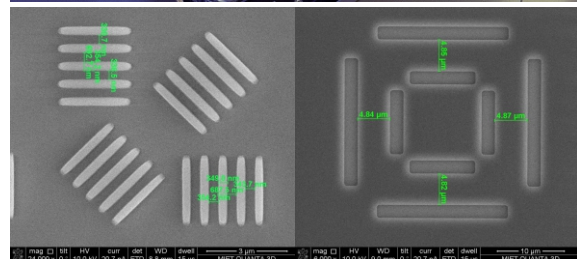
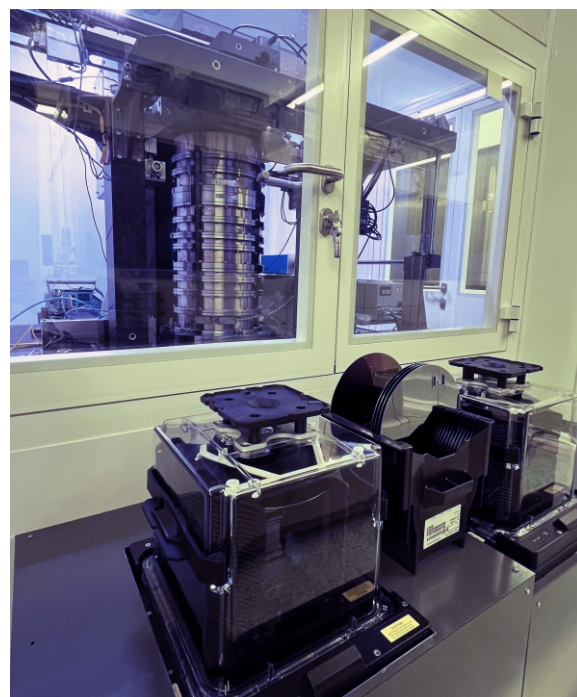
# Установка совмещения и проекционного экспонирования с разрешением 350 нм

## Назначение

Предназначена для проекционного переноса изображения фотошаблона на полупроводниковую пластину и мультипликации его на пластине при изготовлении СБИС с проектной топологической нормой 0,35 мкм.

## Описание

Установка совмещения и проекционного экспонирования с разрешением 350 нм создана в рамках реализации мероприятий по разработке оборудования для обеспечения технологической независимости и предназначена для модернизации существующих и оснащения новых микроэлектронных производств. Используется для производства широкого спектра ЭКБ, в том числе для применения в автомобильной, аэрокосмической отраслях, промышленной автоматике, потребительской электронике и др.



## Основные параметры

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Источник излучения                  | Твердотельный лазер (354,7 нм, 55 Вт, 150 кГц) |
| Рабочая длина волны, нм             | 354,7  |
| Масштаб изображения                 | 1:5 (0,2)                                      |
| Числовая апертура объектива         | 0,45 - 0,6                                     |
| Разрешение, мкм                     | 0,35   |
| Размеры поля изображения, X x Y, мм | 22 x 22  |
| Глубина резкости, мкм               | 0,6  |
| Погрешность совмещения (3σ), нм     | 65   |
| Диаметр обрабатываемых пластин, мм  | 150, 200                                       |
| Производительность, пластин/ч       | 62 (150 мм, 26 кадров)                         |

## Отличительные особенности

- Площадь поля экспонирования 22x22 мм.
- Максимальный диаметр обрабатываемых пластин (200 мм или 150 мм)
- Совместим со SMIF загрузчиками
- Использован твердотельный лазер (354,7 нм), обеспечивающий преимущества, в том числе высокую стабильность излучения, повышенную выходную мощность, высокую долговечность и узкий спектр

Установка разработана и произведена в партнёрстве с белорусским ОАО «Планар»